

параметры F и $T_{\text{ш}}$ связаны соотношением $F = 1 + \frac{1}{T_{\text{ш}}/T_0}$, где $T_0 = 293$ К. Входные малошумящие усилители (МШУ) Р. СВЧ созданы до частот $f =$

(ГИС) и монолитных интегральных схем. На частотах $f > 150$ ГГц применяют волноводные (рис. 5) и квазиоптические конструкции СДШ (рис. 2).

Рис. 3. Квазиоптическая структура для детекторного радиоприемника с распределенным полупроводниковым приемным элементом: 1 — световод; 2 — держатель; 3 — приемный элемент; 4 — иммерсионная линза из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью, такой же, как у приемного элемента; 5 — проводники для подачи смещения на приемный элемент и вывода напряжения детектируемого сигнала.

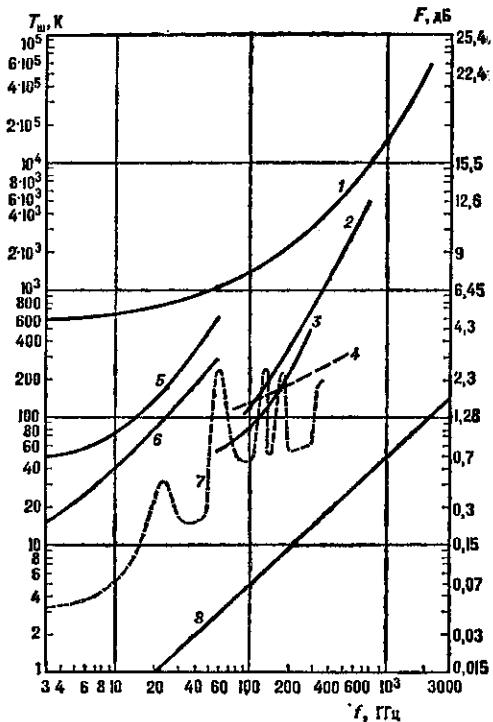
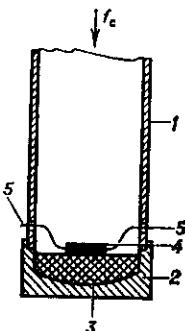


Рис. 4. Частотная зависимость минимальных шумовых параметров радиоприемников и их малошумящих входных каскадов: 1 — неохлаждаемые смесители на диодах Шоттки; 2 — охлаждаемые до 20 К смесители на диодах Шоттки; 3 — сверхпроводниковые СИС-смесители, охлаждаемые до 2 К; 4 — смесители на InSb, охлаждаемые до 4 К; 5 — неохлаждаемые малошумящие усилители на полевых транзисторах Шоттки; 6 — усилители, охлаждаемые до 20 К; 7 — шумы атмосферы; 8 — квантовый шум.

$= 100$ ГГц, однако практическое использование в технике в осн. получили только МШУ до $f \approx 40$ ГГц, причем наиб. эффективными по совокупности характеристики являются МШУ на ПТШ, к-рые повсеместно вытесняют др. виды МШУ, в т. ч. в миллиметровом диапазоне радиоволн. Охлаждение МШУ на этих транзисторах приводит к существенному снижению величины $T_{\text{ш}}$. Из разновидностей входных каскадов Р. СВЧ ближайший к МШУ на ПТШ по величине шумовых параметров смеситель на диодах Шоттки (СДШ), к-рый является самым распространенным малошумящим входным каскадом Р. СВЧ и наиб. продвинутым в КВ-часть радиодиапазона. В своих диапазонах частот СДШ, как и др. функциональные элементы и узлы Р., изготавливаются методами микрорадиотехники в виде гибридно-интегральных схем

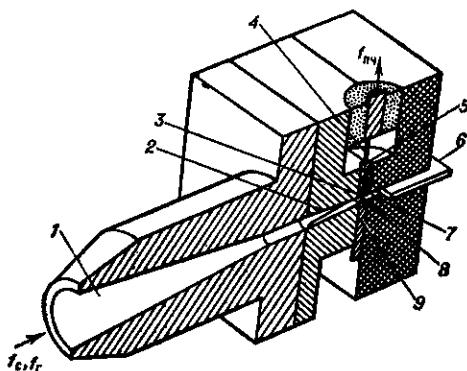


Рис. 5. Смеситель на диодах Шоттки: 1 — рупорная антенна для ввода колебаний сигнала и гетеродина; 2 — конусный переход от круглого волновода к прямоугольному; 3 — кристалл диода Шоттки сотовой структуры; 4 — проводочный вывод сигнала $f_{\text{св}}$; 5 — фильтр низкой частоты из отрезков коаксиальной линии с высоким и низким волновым сопротивлением; 6 — подвижный настроенный короткозамыкающий поршень; 7 — прямоугольный волновод пониженной высоты; 8 — контактная пружинка и ячейка диода Шоттки; 9 — опорный штифт контактной пружинки.

Преобразование частоты осуществляется в смесителе при подведении к нему мощности гетеродина. Большинство гетеродинов, применяемых в СВЧ-диапазоне, создаются на основе полупроводниковых активных элементов — диодов и транзисторов. Для создания гетеродинов на частотах $f \geq 10$ ГГц используют в осн. 2 вида диодов — Ганна-диоды (ДГ) и диоды Шоттки, а также ПТШ. На основе ДГ создают автогенераторы (см. Генератор электромагнитных колебаний), использующие отрицательное дифференциальное сопротивление, возникающее в ДГ. Гетеродины на диодах Ганна (ГДГ) также являются самым распространенным видом гетеродинного автогенератора в диапазоне 10—150 ГГц благодаря своей миниатюрности, экономичности и малым шумам. Они могут быть с фиксированной настройкой (со стабилизацией частоты и без нее) и с механич. или электрич. перестройкой частоты, к-рая в последнем случае часто осуществляется с помощью нелинейной ёмкости, включаемой в колебательный контур (систему) генератора. Обычно в качестве такой ёмкости применяют полупроводниковый диод (напр., диод Шоттки). Для стабилизации частоты используют высокодобротный обтёмный резонатор, чаще в виде диэлектрического резонатора (рис. 6). Для создания гетеродинов на частотах $f > 150$ ГГц применяют умножение частоты на диодах Шоттки. Такие умножители частоты (удвоители, утроители) конструктивно сложны и содержат элементы СДШ. Транзисторные гетеродины на ПТШ в виде переключателей

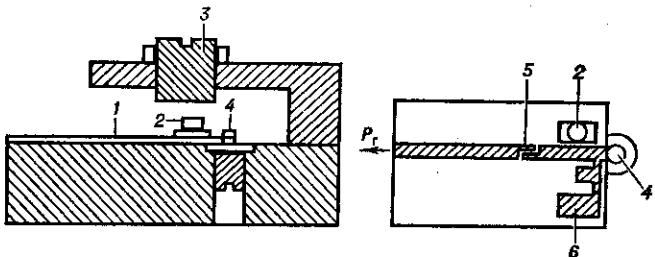


Рис. 6. Конструкция микрополоскового гетеродина на диоде Ганна на $f=50$ ГГц: 1 — микрополосковая плата; 2 — диэлектрический резонатор в форме диска; 3 — виброподстройка рабочей частоты; 4 — диод Ганна; 5 — СВЧ блокировочный конденсатор; 6 — вывод для подачи постоянного напряжения питания.